

AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA A REPUBLICII  
MOLDOVA

**RAPORT DE DOCUMENTARE**

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: a 2019 0057		
(22) Data depozit: 2019.07.12		
(71) Solicitant: <b>UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD</b>		
(54) Titlu: <b>Procedeu de obținere a straturilor de p-GaN</b>		
II. Clasificarea obiectului invenției:		
(51) <b>Int.Cl:</b> <i>H01L 21/02</i> (2006.01)		
<i>H01L 21/18</i> (2006.01)		
<i>H01L 21/20</i> (2006.01)		
<i>H01L 21/205</i> (2006.01)		
III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)		
<b>MD - Intern « Documentare Invenții »</b> (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta): H01L, obținer, strat, GaN, KOH, epitaxia, HVPE, ZnO		
<b>"Worldwide" (Espacenet), PatSearch:</b> ab all "gallium" AND ab all "zinc" AND ab all "potassium" AND ab all "vapour", ab all "GaN" AND ab all "ZnO" AND ab all "KOH", ab all "HVPE" AND ab all "GaN"		
<b>SU, EA, CIS (Eapatis):</b> H01L021/*, H01L021/02, H01L021/18, H01L021/20, H01L021/205 , GaN, KOH, HVPE, ZnO, нитрид* AND галли*, гидроксид* AND кали*, оксид* AND цинк*, эпитакси*, газофазн*		
IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
V. Documente considerate a fi relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D	Aleksandr V. Mazalov, Damir R. Sabitov, Vladimir A. Kureshov, Anatoliy A. Padalitsa, Aleksandr A. Marmalyuk, Rauf Kh. Akchurin. Research of acceptor impurity thermal activation in GaN: Mg epitaxial layers, Modern Electronic Materials, Volume 2, Issue 2, 2016, p. 45-47	1
A, D, C	Hiroshi Amano, Masahiro Kito, Kazumasa Hiramatsu and	1

	Isamu Akasaki. P-Type Conduction in Mg-Doped GaN Treated with Low-Energy Electron Beam Irradiation (LEEBI), Japanese Journal of Applied Physics, Volume 28, Number 12A, 1989, p. L2112-L2114	
A	Shuji Nakamura, Takashi Mukai, Masayuki Senoh Masayuki Senoh and Naruhito Iwasa Thermal Annealing Effects on P-Type Mg-Doped GaN Films, Japanese Journal of Applied Physics, Volume 31, Number 2B, p. L139-L142	1
A	E. Muchuweni, T.S. Sathiaraj, H. Nyakoty. Synthesis and characterization of zinc oxide thin films for optoelectronic applications, Heliyon, Volume 3, Issue 4, 2017	1
A	MD 4618 B1 2019.01.31	1

**\* categoriile speciale ale documentelor citate:**

<b>A</b> – document care definește stadiul anterior general	<b>T</b> – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria pe care se bazează invenția
<b>X</b> – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	<b>E</b> – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată
<b>Y</b> – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	<b>D</b> – document menționat în descrierea cererii de brevet
<b>O</b> - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	<b>C</b> – document considerat ca cea mai apropiată soluție
	<b>&amp;</b> – document, care face parte din aceeași familie de brevete
<b>P</b> - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	<b>L</b> – document citat cu alte scopuri

Data finalizării documentării, 2021.06.04

Examinator, GHIȚU Irina jr.